

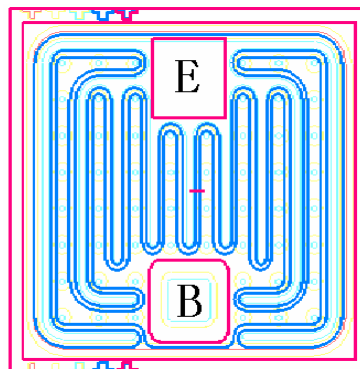


3279 晶体管芯片说明书

芯片简介

芯片尺寸：4 英寸 (100mm)
 芯片代码：C075AJ-01
 芯片厚度：240±20μm
 管芯尺寸：750×750μm²
 焊位尺寸：B 极 165×170μm²；E 极 150×165μm²
 电极金属：铝
 背面金属：金
 典型封装：2SC3279

管芯示意图



极限值 (T_a=25) (TO-92)

T_{stg}——贮存温度.....-55~150
 T_j——结温..... 150
 P_C——集电极功率耗散 (T_a=25)750mW
 V_{CBO}——集电极—基极电压.....30V
 V_{CEO}——集电极—发射极电压.....10V
 V_{EBO}——发射极—基极电压.....6V
 I_C——集电极电流.....2A
 I_B——基极电流.....0.2A

电参数 (T_a=25) (TO-92)

参数符号	符号说明	最小值	典型值	最大值	单位	测试条件
BV _{CBO}	集电极—基极击穿电压	30			V	I _C =1mA, I _E =0
BV _{CEO}	集电极—发射极击穿电压	10			V	I _C =10mA, I _B =0
BV _{EBO}	发射极—基极击穿电压	6			V	I _E =1mA, I _C =0
I _{CBO}	集电极—基极截止电流			0.1	μA	V _{CB} =30V, I _E =0
I _{EBO}	发射极—基极截止电流			0.1	μA	V _{EB} =6V, I _C =0
h _{FE}	直流电流增益	140		600		V _{CE} =1V, I _C =500mA
		70				V _{CE} =1V, I _C =2A
V _{CE(sat)}	集电极—发射极饱和电压			0.82	V	I _C =2A, I _B =50mA
V _{BE(on)}	基极—发射极饱和电压			1.5	V	V _{CE} =1V, I _C =2A
f _T	特征频率		150		MHz	V _{CE} =1V, I _C =500mA
C _{ob}	共基极输出电容		27		pF	V _{CB} =10V, I _E =0, f=1MHz